

半絶縁性単結晶SiCウェハ

半絶縁性単結晶SiCウェハ

半絶縁性単結晶SiCウェハは、その高い**熱伝導率**や**電気絶縁性**から5Gアンテナ向けRFパワーアンプ、複合ウェハ、放熱基板向けに注目されている材料です。

弊社の単結晶SiCウェハは、4インチもしくは6インチウェハから、ご希望の形状に加工し提供する事も可能です。

特 徴

抵抗値

$\geq 1E6\Omega\text{cm}$ (6インチ) $\geq 1E10\Omega\text{cm}$ (4インチ)

熱伝導率

490W/mK (平面方向) 390W/mK (厚み方向)



用 途

- 携帯電基地局用の送信増幅器
- 軍用デバイス
- 高速データ通信



ポリタイプ	Poly Type		4H
密度	Density	g/cm ³	3.21
熱膨張係数	Thermal Expansion Coefficient	10 ⁻⁶ /K	4~5
バンドギャップ	Band Gap	eV	3.23
絶縁破壊電界	Break Down Electrical Field	V/cm	3~5×10 ⁶
飽和ドリフト速度	Saturation Drift Velocity	m/s	2×10 ⁵

商品の詳細は
こちら